

Title (en)

Microwave element used for dissipation or attenuation of energy

Title (de)

Mikrowellenbauelement zur Dissipation oder Dämpfung von Leistung

Title (fr)

Dispositif hyperfréquence destiné à la dissipation ou à l'atténuation de puissance

Publication

EP 1460710 A1 20040922 (FR)

Application

EP 04290686 A 20040312

Priority

FR 0303339 A 20030319

Abstract (en)

The attenuator has a resistive layer (2) deposited on one side of a substrate. The resistive layer has one region connected to a conducting band (5) and another region connected to mass zone (6). The resistive layer is covered by a plan of mass connected to the mass zone and isolated from the resistive layer by an insulating layer. The plan of mass has a conducting material deposited by serigraphy on the insulating layer. An independent claim is also included for a manufacturing process of a power attenuator.

Abstract (fr)

La présente concerne un dispositif (1) hyperfréquence destiné à la dissipation ou à l'atténuation de puissance, notamment un dispositif formant charge résistive ou un atténuateur, comportant : un substrat isolant (3), sur une face (4) du substrat (3), au moins une bande conductrice (5) d'une ligne hyperfréquence, au moins une zone de masse (6), au moins une couche résistive (2) déposée sur la face (4) précitée du substrat, la couche résistive (2) comportant au moins une première région (2a) à laquelle se raccorde la ou une bande conductrice (5) et une seconde région (2b) reliée à la zone de masse (6), la couche résistive (2) présentant un axe longitudinal (X), dispositif dans lequel : la couche résistive (2) est recouverte, au moins partiellement, par un plan de masse relié à la zone de masse (6) et isolé de la couche résistive (2) par une couche isolante. le plan de masse comporte un matériau conducteur déposé par sérigraphie sur la couche isolante. <IMAGE>

IPC 1-7

H01P 1/26; **H01P 1/22**

IPC 8 full level

H01P 1/22 (2006.01); **H01P 1/26** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01P 1/227 (2013.01 - EP US); **H01P 1/268** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [YA] US 4267531 A 19810512 - SPINNER GEORG, et al
- [Y] GB 1326661 A 19730815 - THOMSON CSF
- [A] US 4965538 A 19901023 - MICKEY III JOSEPH J [US]
- [A] US 4672336 A 19870609 - THOMAS NEIL E [GB]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 385 (E - 1249) 17 August 1992 (1992-08-17)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 02 28 February 1997 (1997-02-28)

Cited by

NO338161B1; US7834714B2; US8054157B2; WO2007022906A3; WO2008071271A1

Designated contracting state (EPC)

DE FI FR IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 1460710 A1 20040922; **EP 1460710 B1 20140521**; FR 2852738 A1 20040924; US 2004227232 A1 20041118; US 7161244 B2 20070109

DOCDB simple family (application)

EP 04290686 A 20040312; FR 0303339 A 20030319; US 80316504 A 20040316